

전기전자공학 및 실습 (MEF780)

Midterm Examination

Spring, 2013

1. 그림 1의 회로에서 R_2 에 흐르는 전류의 방향 및 전류의 크기를 구하시오.
 ($V_1 = 10V$; $R_1 = R_2 = R_4 = 1K\Omega$; $R_3 = R_5 = 1K\Omega$; $I_1 = 1mA$; $I_2 = 2mA$)
- 노드 전압법을 사용하여 구하시오. (10pt)
 - 망 전류법을 사용하여 구하시오. (10pt)
 - 소스변환을 사용하여 구하시오. (10pt)

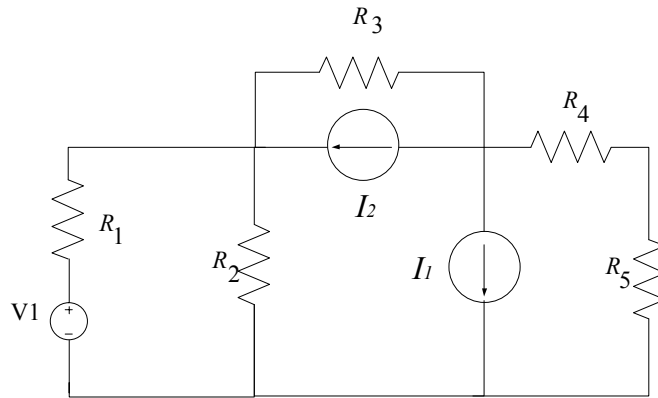


그림 1

2. 그림 2의 회로에서 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1K\Omega$; $V = 5V$; $I = 1mA$ 일 때,
- 노드전압법을 이용하여 전압원에 흐르는 전류를 구하고, 올바른 접지의 위치를 그리시오. (10pt)
 - 중첩의 원리를 이용하여 전압원에 흐르는 전류를 구하시오. (10pt)

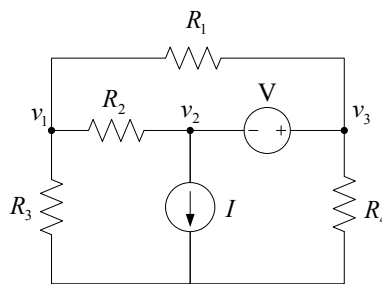


그림 2

3. 그림 3의 회로에서 $I = 0.2A$; $R_1 = 200\Omega$; $R_2 = 75\Omega$; $R_3 = 25\Omega$; $R_4 = 50\Omega$; $V = 10V$ 이다.
- 저항 R_5 가 보는 테브닌 등가저항을 구하여라. (10 pt)
 - R_5 가 부하일 때 테브닌 등가전압을 구하고 테브닌 등가회로를 구성하라. (10pt)
 - 부하 R_5 로 최대의 전력이 전달되기 위한 R_5 값을 구하시오. (10pt)

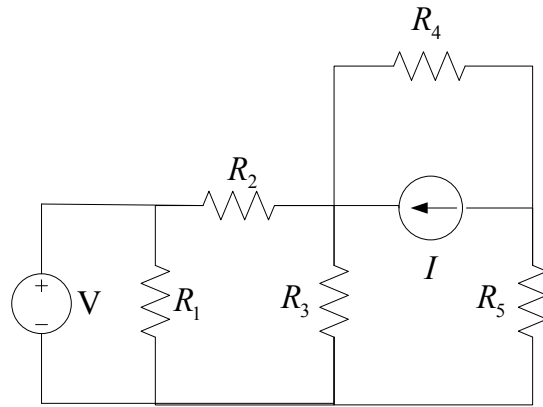


그림 3

4. 미지의 소스회로를 노턴 및 테브닌 등가회로로 표현하려고 한다. 노턴/테브닌 등가저항, 노턴 등가전류, 테브닌 등가전압을 실험을 통하여 결정하는 방법을 설명하고, 측정기의 저항에 따른 오차에 대하여 논하시오. (10)

5. 망 전류해석을 사용하여 그림 4의 회로에서 전압이득 $A_v = v_2 / v_1$ 를 구하여라. (10)

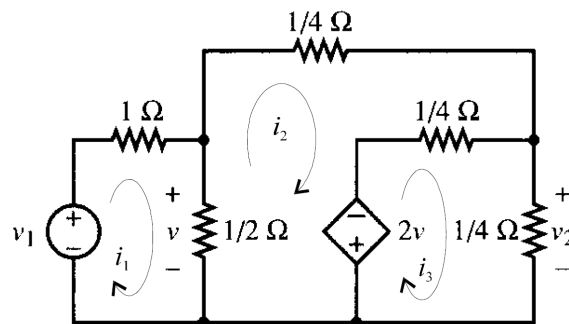


그림 4

전기전자공학 및 실습 (MEF780)
Midterm Examination

Spring, 2013

학번 _____

이름 _____